查询2SB965供应商　　捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货



# 2SB965/2SD1288

**PNPエピタキシアル/NPN三重拡散形 シリコントランジスタ低周波電力増幅用**

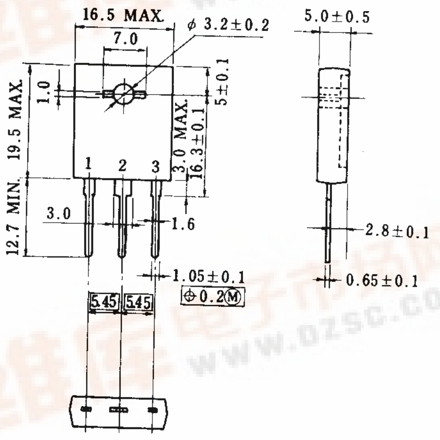
PNP Silicon Epitaxial/NPN Triple Diffused Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

## 特長／FEATURES

- ○実効出力25～45 W(Single-PP, $R_L$=8 Ω)のパワーアンプ出力用。
- ○New EBT構造を採用, $f_T$が高く, 破壊強度が優れています。
- ○直流電流増幅率$h_{FE}$の電流特性が優れています。

## 外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)




電極接続
1. ベース
2. コレクタ(放熱板)
3. エミッタ

## 絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a$=25 ℃)

| 項目 | 略号 | 2SB965 | 2SD1288 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| コレクタ・ベース間電圧 | $V_{CBO}$ | −120 | 120 | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO}$ | −120 | 120 | V |
| エミッタ・ベース間電圧 | $V_{EBO}$ | −5.0 | 5.0 | V |
| コレクタ電流 | $I_{C(DC)}$ | −7.0 | 7.0 | A |
| コレクタ電流 | $I_{C(pulse)}$ * | −10 | 10 | A |
| 全損失 | $P_T$ ($T_c$=25 ℃) | 70 | | W |
| ジャンクション温度 | $T_j$ | 150 | | ℃ |
| 保存温度 | $T_{stg}$ | −55～+150 | | ℃ |

*PW≦10 ms, duty cycle≦50 %

## 電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a$=25 ℃)

2SB965/2SD1288

| 項目 | 略号 | 条件 | | MIN. | TYP. | MAX. | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクタしゃ断電流 | $I_{CBO}$ | $V_{CB}$=−120/120 V, $I_E$=0 | | | | −50/50 | μA |
| エミッタしゃ断電流 | $I_{EBO}$ | $V_{EB}$=−5.0/5.0 V, $I_C$=0 | | | | −50/50 | μA |
| 直流電流増幅率 | $h_{FE1}$ | $V_{CE}$=−5.0/5.0 V, $I_C$=−50/50 mA | * | 40 | 150/120 | | |
| 直流電流増幅率 | $h_{FE2}$ | $V_{CE}$=−5.0/5.0 V, $I_C$=−1.0/1.0 A | * | 60 | 140 | 320 | |
| コレクタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C$=−4.0/4.0 A, $I_B$=−0.4/0.4 A | * | | −0.55/0.50 | −1.5/1.5 | V |
| ベース飽和電圧 | $V_{BE(sat)}$ | $I_C$=−4.0/4.0 A, $I_B$=−0.4/0.4 A | * | | −1.25/1.25 | −2.0/2.0 | V |
| コレクタ容量 | $C_{ob}$ | $V_{CB}$=−10/10 V, $I_E$=0, f=1.0 MHz | | | 150/85 | | pF |
| 利得帯域幅積 | $f_T$ | $V_{CE}$=−5.0/5.0 V, $I_C$=−1.0/1.0 A | | | 75/55 | | MHz |

*パルス測定　PW≦350 μs, duty cycle≦2 %

$h_{FE2}$区分/R：60～120 Q：100～200 P：160～320

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com